

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第6部門第2区分
 【発行日】令和1年5月23日(2019.5.23)

【公開番号】特開2017-10000(P2017-10000A)
 【公開日】平成29年1月12日(2017.1.12)
 【年通号数】公開・登録公報2017-002
 【出願番号】特願2016-77459(P2016-77459)
 【国際特許分類】

G 0 9 G 3/3225 (2016.01)
 G 0 9 G 3/20 (2006.01)
 G 0 9 G 3/30 (2006.01)
 H 0 1 L 51/50 (2006.01)

【F I】

G 0 9 G 3/3225
 G 0 9 G 3/20 6 2 4 B
 G 0 9 G 3/30 J
 G 0 9 G 3/20 6 1 1 H
 G 0 9 G 3/20 6 4 2 A
 H 0 5 B 33/14 A

【手続補正書】

【提出日】平成31年4月8日(2019.4.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

トランジスタと、
 第1乃至第3のスイッチと、
 第1の容量素子及び第2の容量素子と、
 発光素子と、
 第1乃至第4の配線と、を有し、
 前記トランジスタは、第1のゲート及び第2のゲートを有し、
 前記第1のゲートと第2のゲートとは、前記トランジスタのチャンネル形成領域を間に介して互いに重なる領域を有し、
 前記第1のゲートは、前記第1のスイッチを介して、前記第1の配線に電氣的に接続され、
 前記トランジスタの第1端子は、前記第3の配線に電氣的に接続され、
 前記トランジスタの第2端子は、前記第3のスイッチを介して、前記第1のゲートに電氣的に接続され、
 前記第2のゲートは、前記第2のスイッチを介して、前記第2の配線に電氣的に接続され、
 前記発光素子の第1端子は、前記トランジスタの第2端子に電氣的に接続され、
 前記発光素子の第2端子は、前記第4の配線に電氣的に接続され、
 前記第1の容量素子の第1端子は、前記第1のゲートに電氣的に接続され、
 前記第1の容量素子の第2端子は、前記トランジスタの第2端子に電氣的に接続され、
 前記第2の容量素子の第1端子は、前記第2のゲートに電氣的に接続され、

前記第 2 の容量素子の第 2 端子は、前記トランジスタの第 2 端子に電氣的に接続される、表示装置。

【請求項 2】

請求項 1 において、

前記トランジスタは、nチャネル型トランジスタである、表示装置。

【請求項 3】

請求項 1 または請求項 2 において、

前記チャネル形成領域は、酸化物半導体を有する、表示装置。

【請求項 4】

請求項 1 乃至3のいずれか一項において、

前記第 1 乃至前記第 3 のスイッチの各々は、トランジスタである、表示装置。

【請求項 5】

請求項 1 乃至3のいずれか一項において、

前記第 1 乃至前記第 3 のスイッチの各々は、チャネル形成領域に酸化物半導体を有するトランジスタである、表示装置。

【請求項 6】

トランジスタと、

第 1 のスイッチ及び第 2 のスイッチと、

第 1 の容量素子及び第 2 の容量素子と、

発光素子と、

第 1 乃至第 4 の配線と、を有し、

前記トランジスタは第 1 のゲート及び第 2 のゲートを有し、

前記第 1 のゲートと第 2 のゲートとは、前記トランジスタのチャネル形成領域を間に介して互いに重なる領域を有し、

前記第 1 のゲートは、前記第 1 のスイッチを介して、前記第 1 の配線に電氣的に接続され、

前記トランジスタの第 1 端子は、前記第 3 の配線に電氣的に接続され、

前記第 2 のゲートは、前記第 2 のスイッチを介して、前記第 2 の配線に電氣的に接続され、

前記発光素子の第 1 端子は、前記トランジスタの第 2 端子に電氣的に接続され、

前記発光素子の第 2 端子は、前記第 4 の配線に電氣的に接続され、

前記第 1 の容量素子の第 1 端子は、前記第 1 のゲートに電氣的に接続され、

前記第 1 の容量素子の第 2 端子は、前記トランジスタの第 2 端子に電氣的に接続され、

前記第 2 の容量素子の第 1 端子は、前記第 2 のゲートに電氣的に接続され、

前記第 2 の容量素子の第 2 端子は、前記トランジスタの第 2 端子に電氣的に接続される、表示装置。

【請求項 7】

請求項 6 において、

前記トランジスタは、nチャネル型トランジスタである、表示装置。

【請求項 8】

請求項 6 または 7 において、

前記チャネル形成領域は、酸化物半導体を有する、表示装置。

【請求項 9】

請求項 6 乃至 10 のいずれか一項において、

前記第 1 および前記第 2 のスイッチは、トランジスタである、表示装置。

【請求項 10】

請求項 6 乃至 10 のいずれか一項において、

前記第 1 および前記第 2 のスイッチは、チャネル形成領域に酸化物半導体を有するトランジスタである、表示装置。